

株式会社 アルバック

中期経営計画進捗 (FY20-22)

2022.秋

証券コード : 6728

Breakthrough 2022

将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。



アルバックのご紹介

— 経営基本理念 —

アルバックグループは、互いに協力・連携し、**真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、産業と科学の発展に貢献することを目指す**

商号 株式会社 アルバック (英語名称 : ULVAC, Inc.)
創業 1952年8月23日 創業時社名 日本真空技術(株)
2001年4月から(株)アルバック
「真空技術で日本の産業に貢献しよう」と集まった若い研究者達の熱い情熱に動かされた6人のエンジェルの出資で誕生

代表者 代表取締役執行役員社長 岩下節生

資本金 208億7304万2500円

従業員数 6,235名 (連結 : 2022年6月30日現在)

本社所在地 神奈川県茅ヶ崎市

決算期 6月

【6人のエンジェル】

石川芳次郎	(京福電鉄 社長、当社初代社長)
大沢 善夫	(大沢商会 会長)
松下幸之助	(松下電器産業 (現パナソニック) 社長)
藤山愛一郎	(大日本製糖社長、後の外務大臣)
山本為三郎	(アサヒビール 社長)
弘世 現	(日本生命保険相互会社 社長)



社名の由来

ULVAC

Ultimate in Vacuum
真空の極限を追求する

2. 2021年度事業別売上高（連結）

真空応用事業
412 億円 **17%**

83% 真空機器事業
2,001 億円

■ 材料



半導体用



液晶ディスプレイ用

■ 一般産業用装置



凍結乾燥装置



希土類磁石製造装置

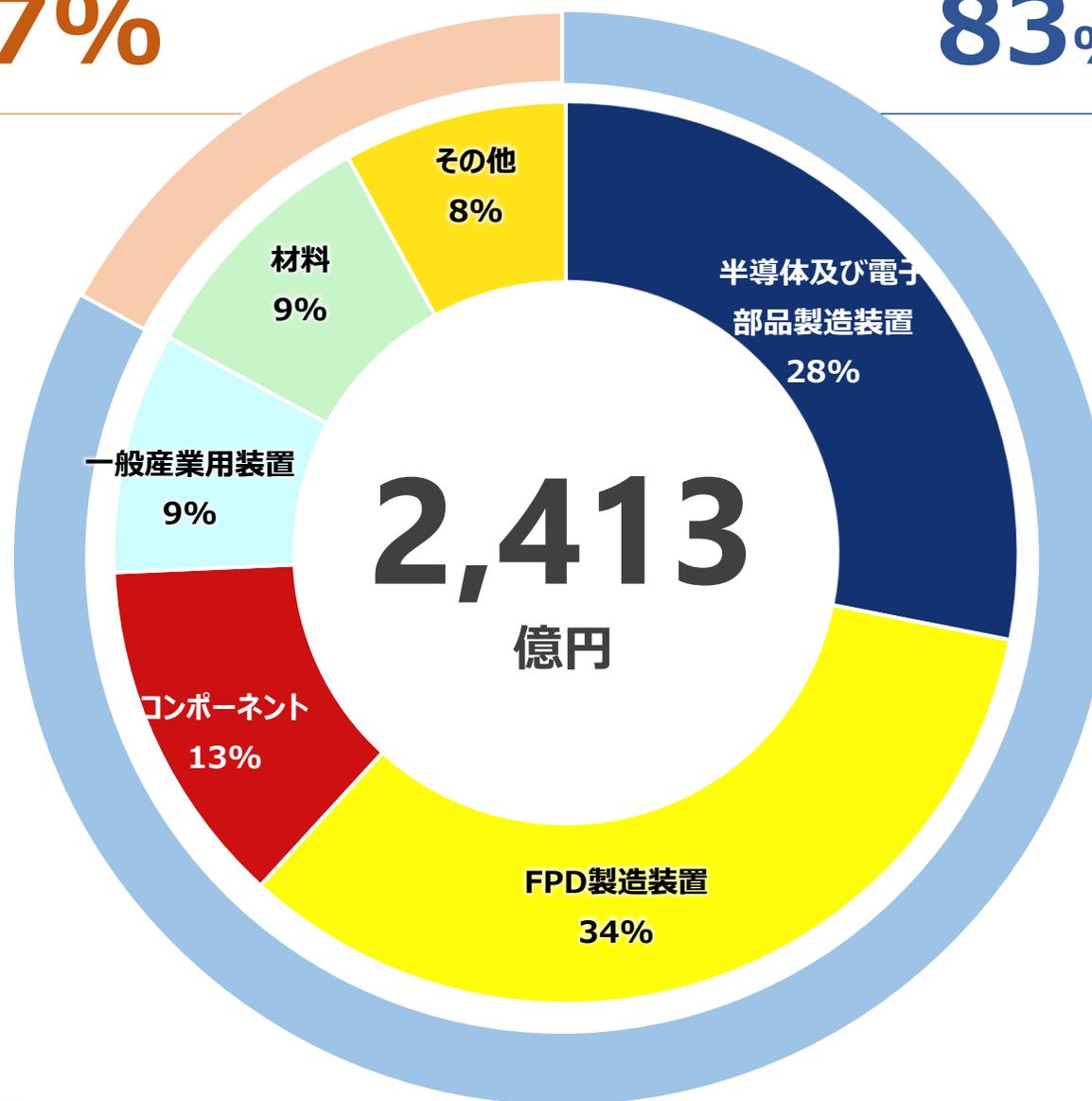
■ コンポーネント



ドライポンプ



リークディテクター



■ 半導体・電子部品製造装置



半導体用
スパッタリング装置



エッチング装置

■ FPD製造装置



スパッタリング装置



OLED製造装置

幅広い領域・多様な技術の融合

【装置】
スパッタ
蒸着
CVD
イッチャー等

コンポーネント

マテリアル

カスタマーサポート

東アジアの強力なネットワーク

幅広い顧客基盤

先端研究機関ネットワーク

開発・営業・CS拠点網

製造拠点・サプライヤー網

技術革新への対応力

真空薄膜形成技術

装置・プロセス・材料等の基盤技術

世界のリーディング企業や
先端研究機関と連携

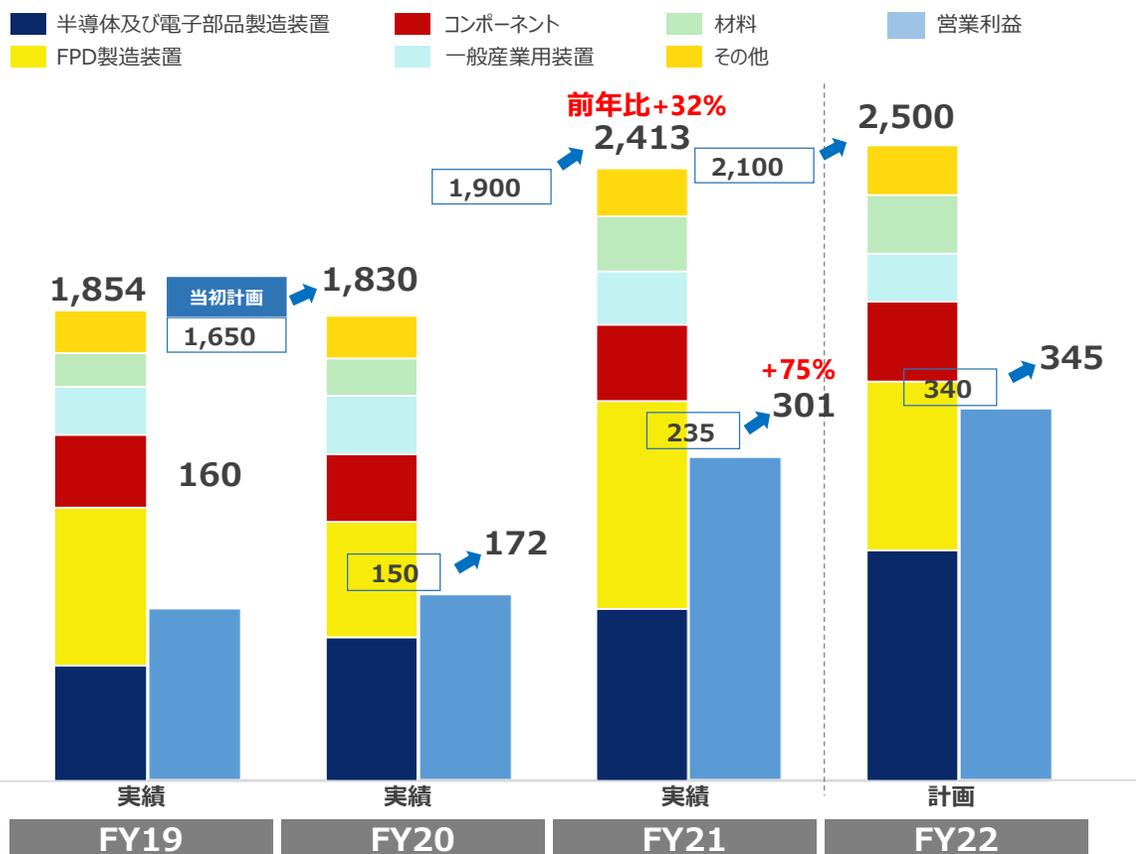


中期経営計画

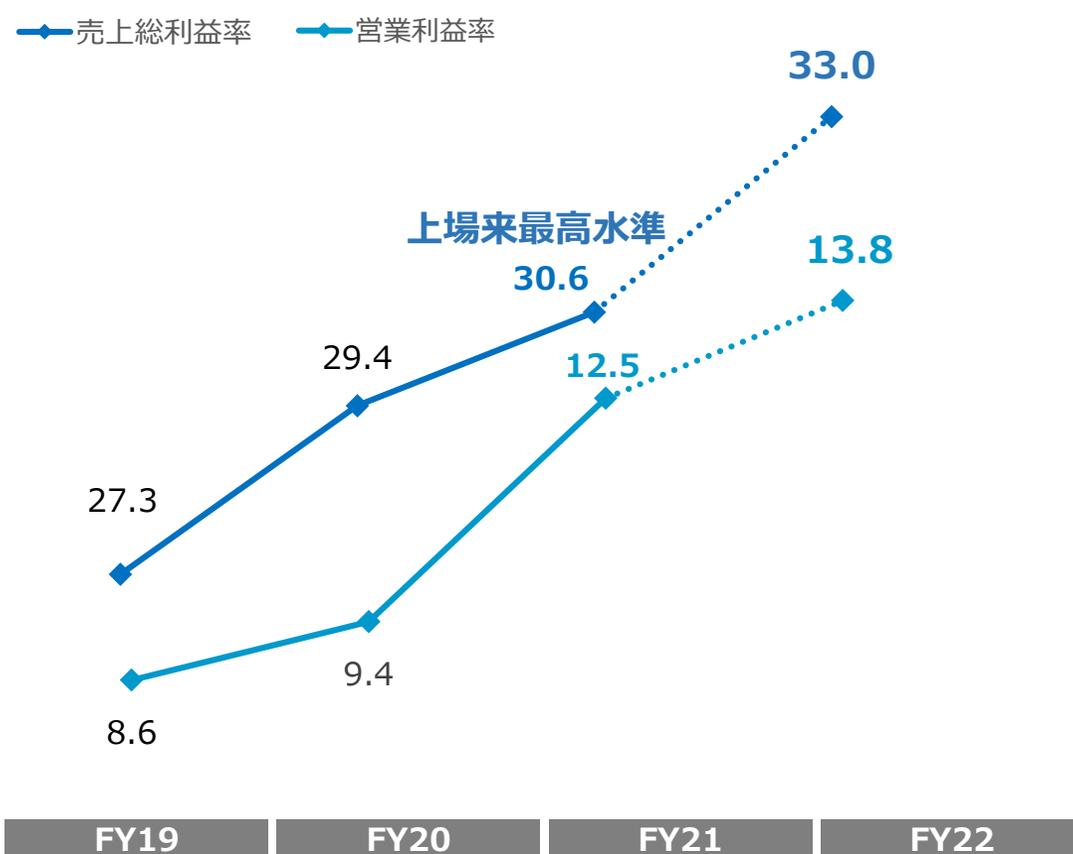
1. 中期経営計画推移・22年度計画

- 20年度・21年度は、売上高・営業利益ともに、当初計画を大きく上回る
- 利益率の高い半導体・電子の成長によりミックスも改善
- 利益率も①モノづくり力強化による利益率改善、②売上増加、③ミックス改善等により大きく改善

売上高・営業利益（率） 【単位：億円】



売上総利益・営業利益率 【単位：%】



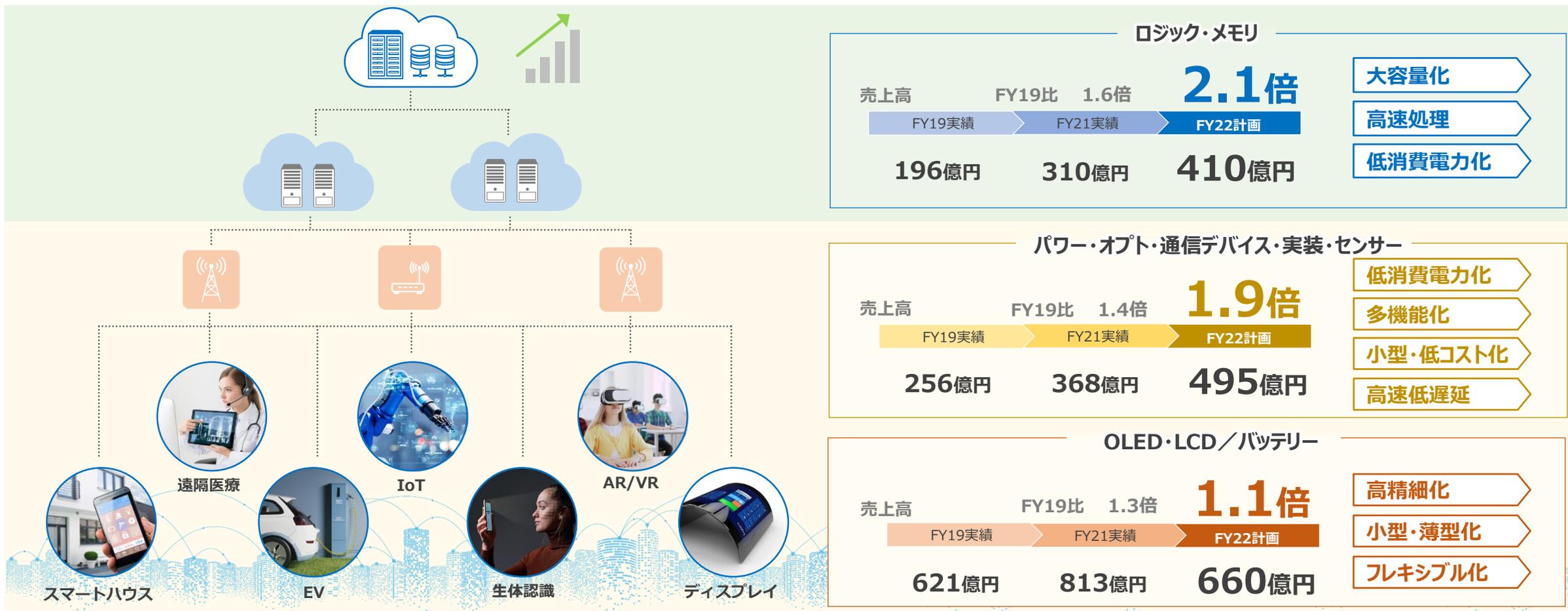
2. 連結業績推移

- 22年度は、売上高2,500億円（前年同期比4%増）、営業利益345億円（同15%増）、営業利益率13.8%の計画

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
【単位：億円】	実績	実績	実績	計画
受注高	1,566	1,989	2,701	2,700
売上高	1,854	1,830	2,413	2,500
営業利益	160	172	301	345
率	8.6%	9.4%	12.5%	13.8%
経常利益	181	180	322	355
率	9.7%	9.8%	13.3%	14.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	108	148	202	230
率	5.8%	8.1%	8.4%	9.2%

3. 半導体・電子・FPD : 中長期的に投資拡大継続

- 「スマート社会化・デジタル化+メタバース」×「グリーンエネルギー化」
半導体・各種電子デバイス・ディスプレイ : 「技術革新投資」×「増産投資」
- 各国支援による地域サプライチェーン構築のための投資も活発化

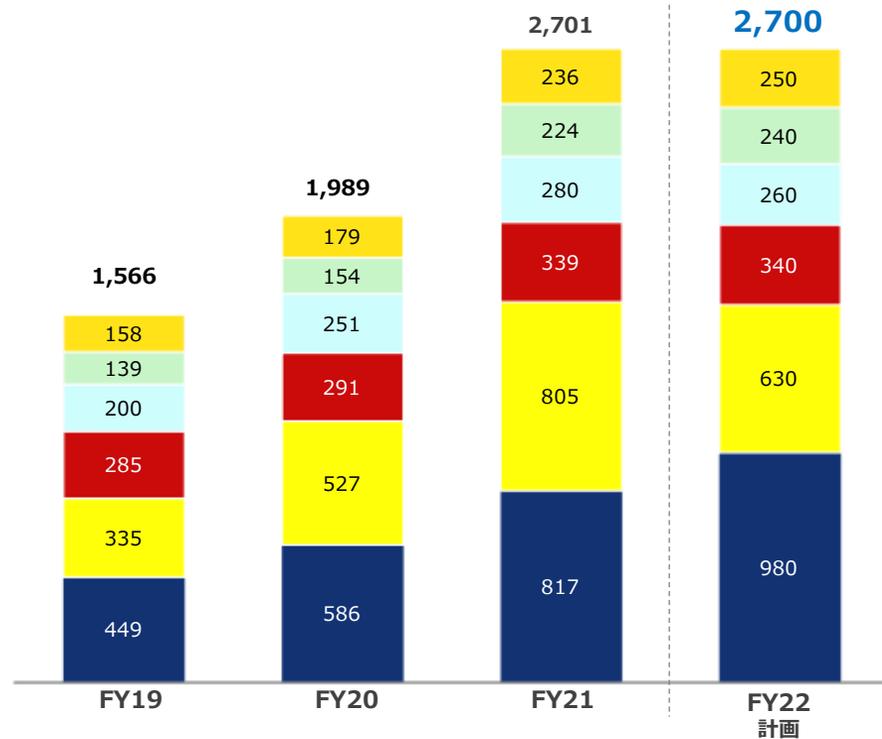


4. 2022年度 受注高・売上高計画

- FPDは21年度に急増したITパネル用LCD投資の反動で減少
⇒23年度以降：ITパネル用大型基板OLED・バッテリー向けなどで700~800億円を見込む
- 半導体（ロジックMHM工程・新規工程）・電子（パワーデバイス、中国国産化投資等）が成長を牽引
⇒受注高は2,700億円と高水準、売上高は2,500億円（前年同期比4%増）を計画

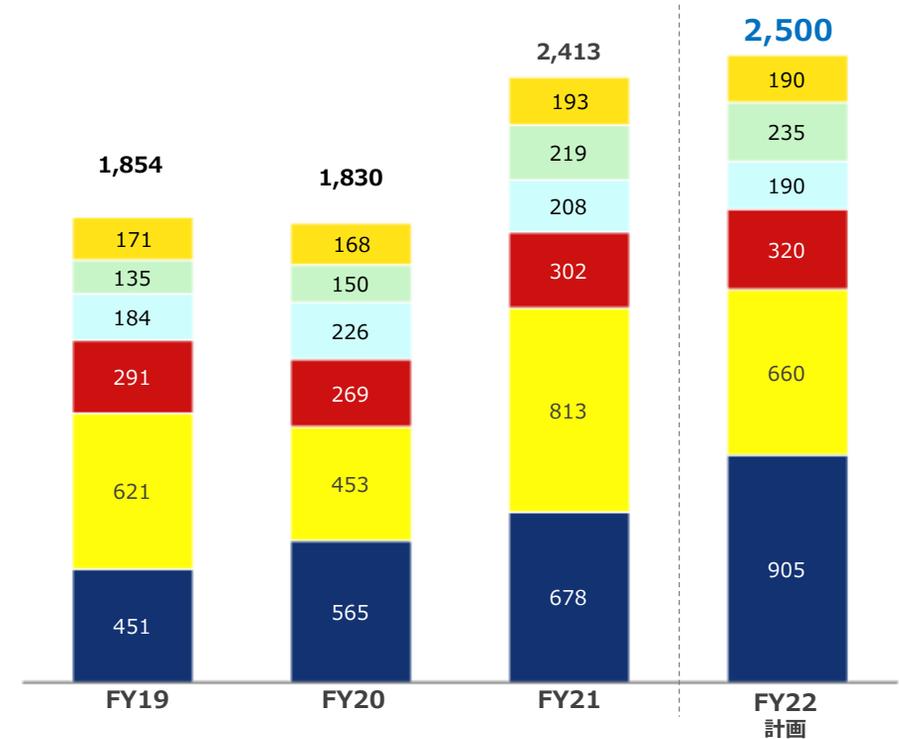
受注高

【単位：億円】



売上高

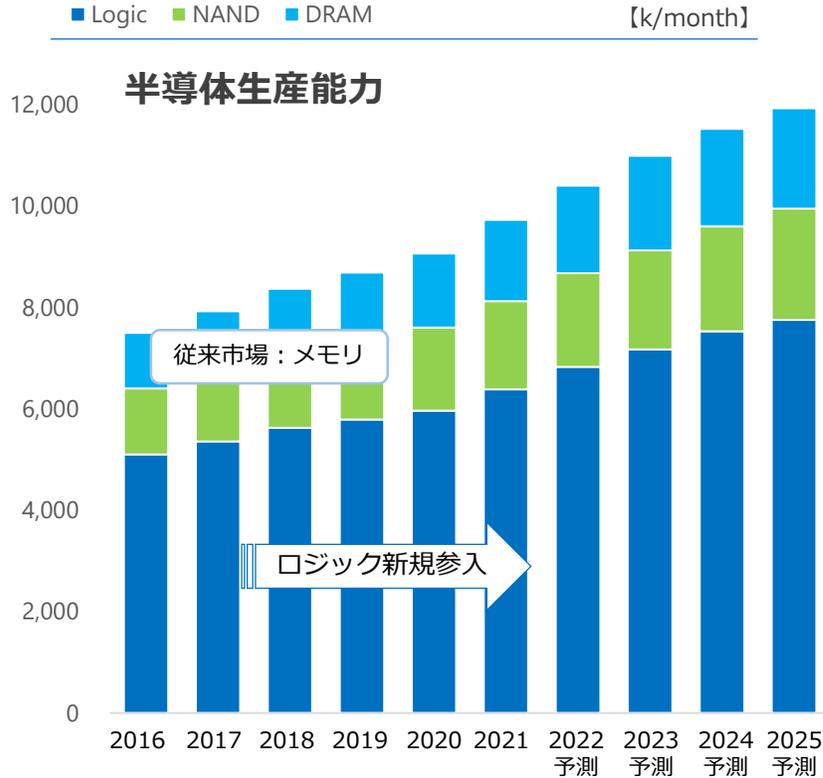
【単位：億円】



5-(1)半導体：ロジックMHM工程参入⇒他工程参入で成長

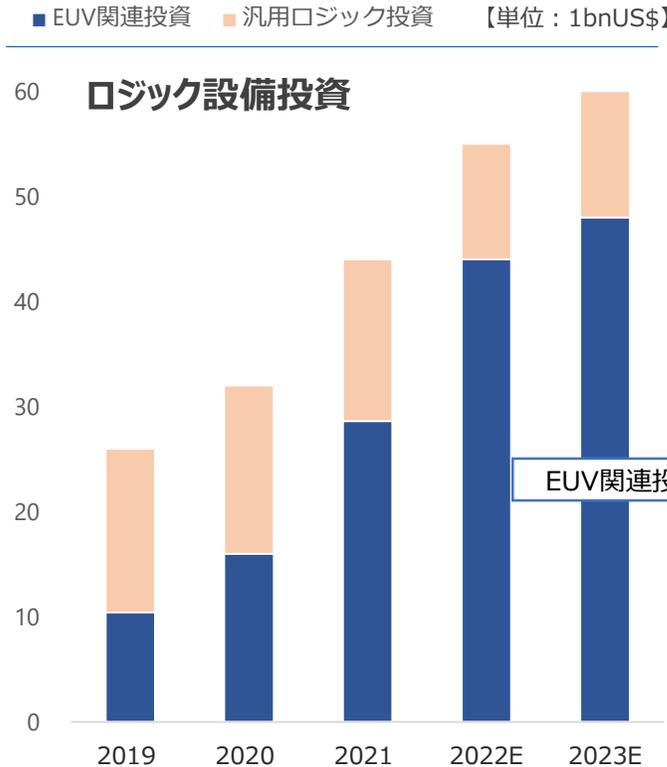
- 18年、ロジック分野でEUV導入により必要となる**メタル・ハード・マスク（MHM）工程参入実現**
- **5ナノ以下のMHM工程は全て当社装置採用⇒EUV関連最先端投資の増加とともに市場を上回る成長**
- **セカンドベンダー期待からMHM以外の他工程（ロジック・メモリ）への参入機会増加**

ロジック参入でビジネスチャンス拡大



出所：SEMI等をもとに当社予測

EUV関連投資拡大：8割



出所：SEMI,各社投資計画等をもとに当社予測

セカンドベンダー期待

半導体メーカーは1社購買を嫌い、セカンドベンダーを希求
⇒アルバックのロジック参入により2社体制に

半導体スパッタリング装置ランキング

	2010年		2018年～
	メモリ	ロジック	メモリ・ロジック
AMAT	①	①	①
アルバック	②	—	②
キャノンアネルパ	③	—	
ノベラス→ラムリサーチ	④	②	

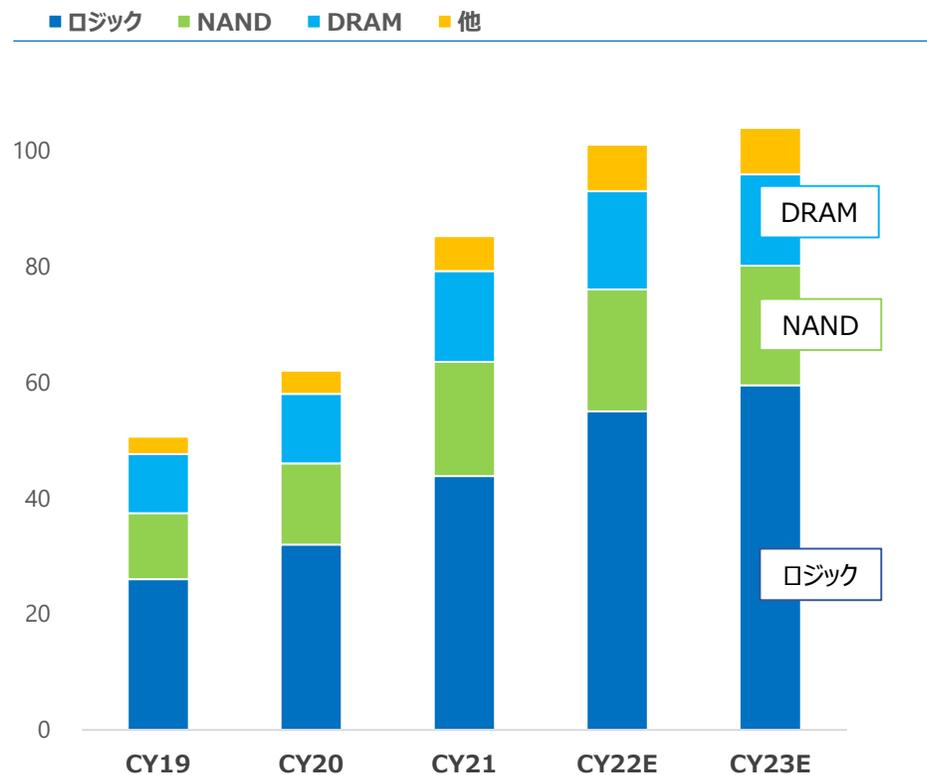
ノベラスを買収したラムリサーチが2013年にスパッタ装置から撤退
⇒ロジック分野では2018年までAMAT一社購買に

5-(2)ロジック・メモリ両輪で成長実現

- ロジック：MHM工程・他工程参入・新規顧客等により19年度比3.9倍の計画
- メモリ：従来工程・他工程参入・新規顧客等により高水準継続

半導体設備投資予測

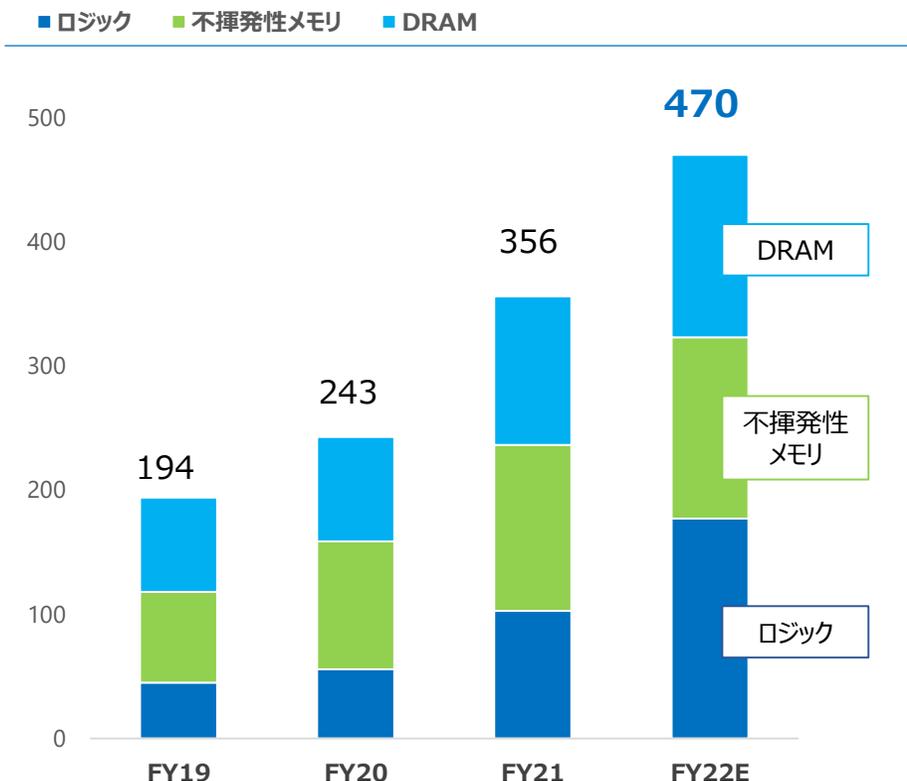
【単位：1bnUS\$】



出所：SEMI

受注計画

【単位：億円】



6-(1)電子：各種電子デバイス分野

	主なデバイス	最終用途
<p>パワーデバイス</p>	IGBT SiC Si-MOSFET	<ul style="list-style-type: none"> EV車載デバイス インバータモータ 産業用ロボット 省電力機器
<p>オプトデバイス</p>	μOLED 反射防止膜 バンドパスフィルター	<ul style="list-style-type: none"> AR/VR 車載用インパネ 3Dセンサー
<p>通信デバイス</p>	SAW・BAWフィルター RFデバイス	<ul style="list-style-type: none"> スマートフォン 無線基地局
<p>電子部品 (MEMS)</p>	Piezo-MEMS 各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> 指紋認証 LiDAR 電源デバイス
<p>実装</p>	FanOut WLP・PLP Info-package	<ul style="list-style-type: none"> PC スマートフォン データサーバ IoTデバイス

装置ラインアップ

★ スパッタリング装置

蒸着装置

★ イオン注入装置

CVD装置

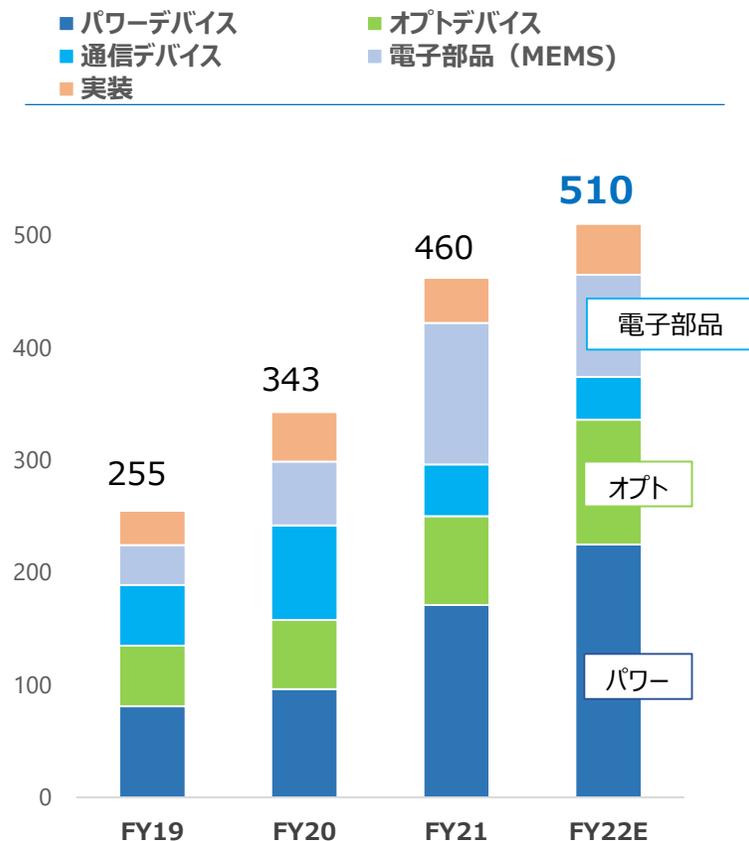
エッチング装置

★ アッシング装置

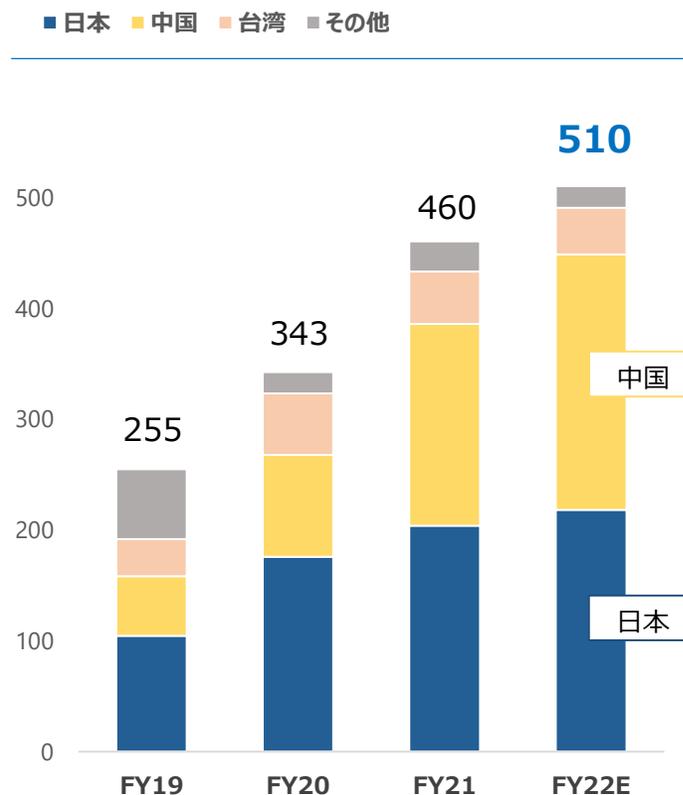
6-(2)電子：パワーデバイス・中国の国産化政策が成長ドライバー

- EV用・省エネ対応等でパワーデバイスの高性能化・増産投資活発化
- 中国の国産化政策で、パワーデバイス・各種電子デバイス投資活発化

受注計画（分野別） 【単位：億円】



受注計画（地域別） 【単位：億円】



パワーデバイス

日本：
IGBT用スパッタ装置でトップシェア（従来8インチ）
⇒12インチ化・SiC化投資

中国：
SiC用イオン注入装置で7割以上のシェア⇒投資活発化

電子デバイス

オプトデバイス：
AR/VR用μOLED、車載用反射防止膜等の投資活発化

各種電子デバイス：
スマート社会化・メタバース化など技術革新に伴う投資活発化

6-(3)パワーデバイスは高成長継続

● グリーンエネルギー化・EV化進展等に伴いパワーデバイスの高成長継続

	IGBT	SiC	Si-MOSFET
市場環境	<p>日本</p> <ul style="list-style-type: none"> 8inch増産投資 + 12inch投資開始 <p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> 国産化方針・地方政府支援 	<p>日本</p> <ul style="list-style-type: none"> 8inch投資開始 <p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> 国産化方針・地方政府支援 6inch増産投資拡大 	<p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> 国産化方針・地方政府支援 家電製品等のインバーター化 Low～Midエンド機器の需要旺盛
アルバックの強み	<p>日本</p> <ul style="list-style-type: none"> 裏面電極用スパッタ装置で高いシェア 日系主要各社との豊富な実績 	<p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> SiC用イオン注入装置シェア7割 エンジニア派遣常駐による技術営業力 	<p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> 現地生産による価格競争力 現地設計によるカスタマイズ対応 サプライチェーン体制構築
成長戦略	<p>日本</p> <ul style="list-style-type: none"> スパッタ装置展開 <p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> イオン注入装置展開 	<p>日本</p> <ul style="list-style-type: none"> スパッタ装置展開 <p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> イオン注入装置・スパッタ装置展開 	<p>中国</p> <ul style="list-style-type: none"> 蒸着装置 高水準堅持
	<p>★  スパッタリング装置</p>	<p>★  イオン注入装置</p>	<p> 蒸着装置</p>

電子デバイス需要増加・輸入依存脱却

- ・パワーデバイス
- ・各種電子デバイス



中国国産化方針

- ・サプライチェーンの安定化
- ・貿易収支改善

地方政府支援（各種優遇・支援）

中国国内投資加速化（景気対策）

新エネルギーシフト（グリーン化）

- ・再生可能エネルギーシフト
- ・新エネルギー車回復・増加
- ・LiB生産量増加

デジタルインフラ建設

- ・5G基地局
- ・データセンター

沿海部中心にパワー・電子デバイス工場建設増



7-(1) FPD : OLED化・EVバッテリー用巻取蒸着装置が牽引

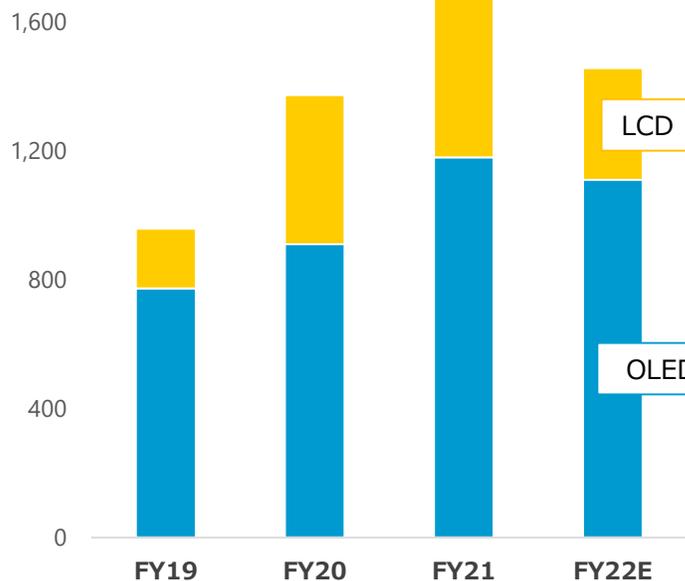
- ITパネル（タブレット・PC・車載用・医療用・ゲーム用等）投資活発化
21年度：LCD投資集中 ⇒ 22~23年度：大型基板OLED投資本格化（量産開発中）
- EVバッテリーの小型大容量化等に向けた巻取蒸着装置が今年度より寄与・成長期待

FPD設備投資動向

【単位：億円】

（蒸着・スパッタ）

■ OLED ■ LCD

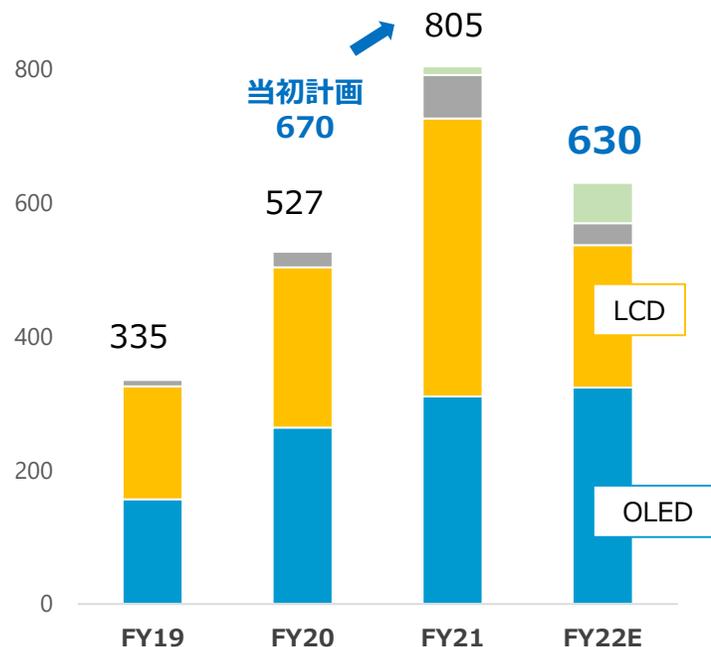


出所：当社予測

受注計画

【単位：億円】

■ OLED ■ LCD ■ キャパシタ・その他 ■ バッテリー



大型基板OLED用スパッタ装置

- 21年度はITパネル用LCD投資が集中
- 大型基板OLEDの量産開発が進捗するが22年度は一時的な端境期
- 23年度以降、OLED投資がパネル投資を本格牽引 ⇒ 枚葉型G8.5スパッタ装置でトップシェア狙う

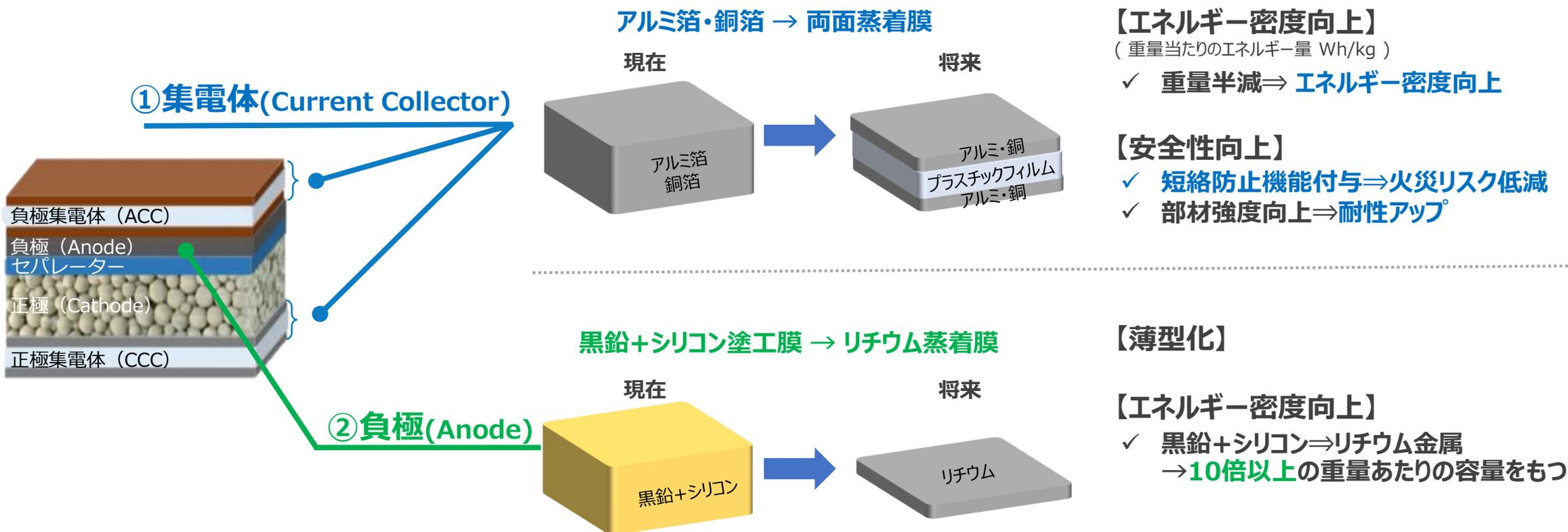
バッテリー用巻取蒸着装置

- EVバッテリーの小型大容量化・安全性向上に向けた巻取蒸着装置が今年度より貢献 ⇒ 23年度以降拡大

23年度以降は大型基板OLEDのスパッタ装置・バッテリー用巻取蒸着装置中心に受注回復（700~800億円程度）を見込む

● EVバッテリーの小型大容量化、安全性向上実現のため、巻取蒸着装置を開発

- ①集電体：安全性・軽量化実現のため、金属箔の両面蒸着フィルムへの置き換え投資開始(22年度)
 - ②負極：大容量化実現のため、従来の「黒鉛+シリコン」⇒「リチウム蒸着膜」：開発中
- ⇒NEDOグリーンイノベーション基金事業「次世代蓄電池・次世代モーターの開発」採択



コンポーネント

半導体電子・EV関連 投資活発化



- 半導体電子製造装置用ポンプ・DC/RF電源需要堅調
- EV用リチウムイオン電池・燃料電池向けリークディテクター増加
- OLED・半導体電子用クライオポンプ堅調



スクルー型ドライ真空ポンプ
LSシリーズ

リークディテクター

マテリアル

半導体向け 受注拡大



- 先端半導体向け高品質焼結ターゲット (W・WSi等) 増加
- 半導体装置と連動したターゲット (Al、Ti等)
→半導体ビジネスを成長の柱に
- LCD・OLEDの高精細化・低消費電力化を実現するIGZOが増加



半導体向け
W スパッタリングターゲット



半導体向け
Ti スパッタリングターゲット

カスタマーサポート

装置稼働率上昇 受注拡大



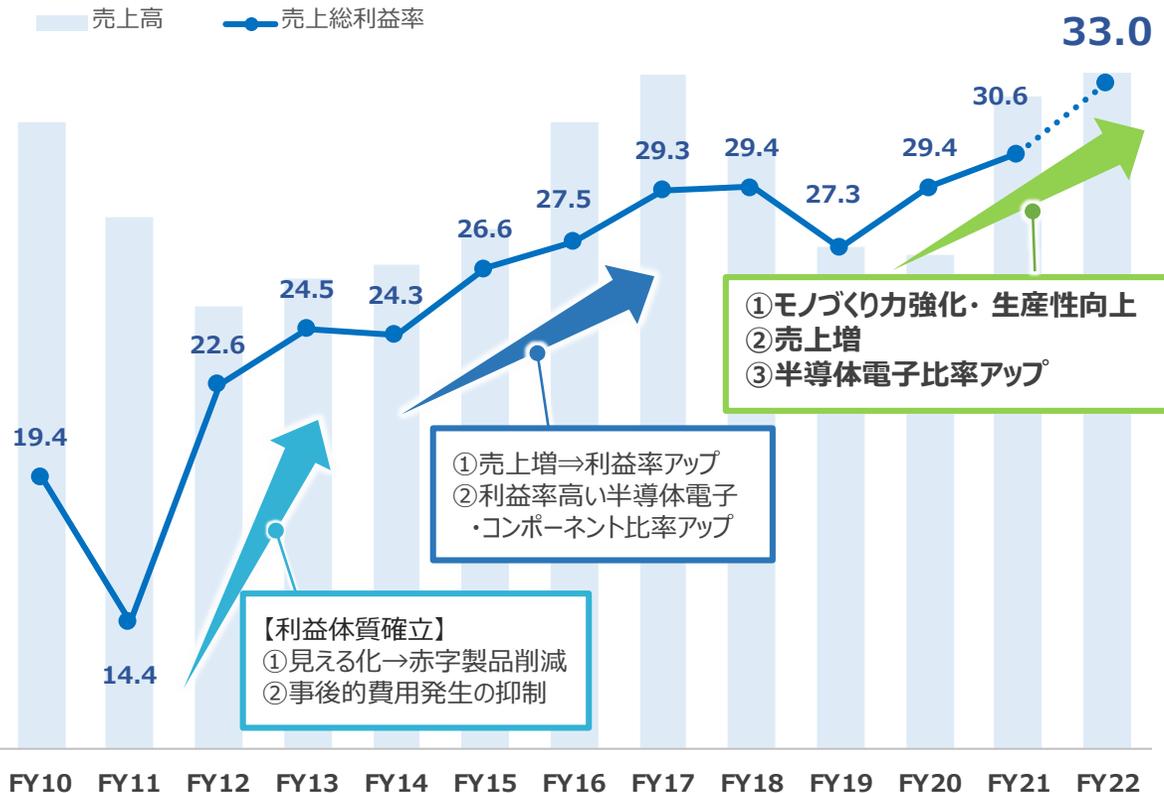
- 半導体電子の投資活発化・装置稼働率上昇に伴い、受注増加
- 日本、中国、韓国、台湾で部品販売・CIPビジネス拡大



9. モノづくり力強化による利益率改善を推進

- 部材長納期化・価格上昇の影響はあるものの、モノづくり力強化により、**売上総利益率は着実に改善**
- 22年度は売上総利益率33%を目指す

売上総利益率推移 【単位：%】



技術設計の改革

技術図面の完成度向上
設計バリューエンジニアリング強化

購買の改革

購買体制一体化
グローバル・サプライチェーン



生産工程の改革

生産拠点の専門化
製造生産性向上

情報システム基盤強化

業務プロセス標準化
生産性向上・経営管理の高度化

10. 中期経営計画の取り組みの進捗

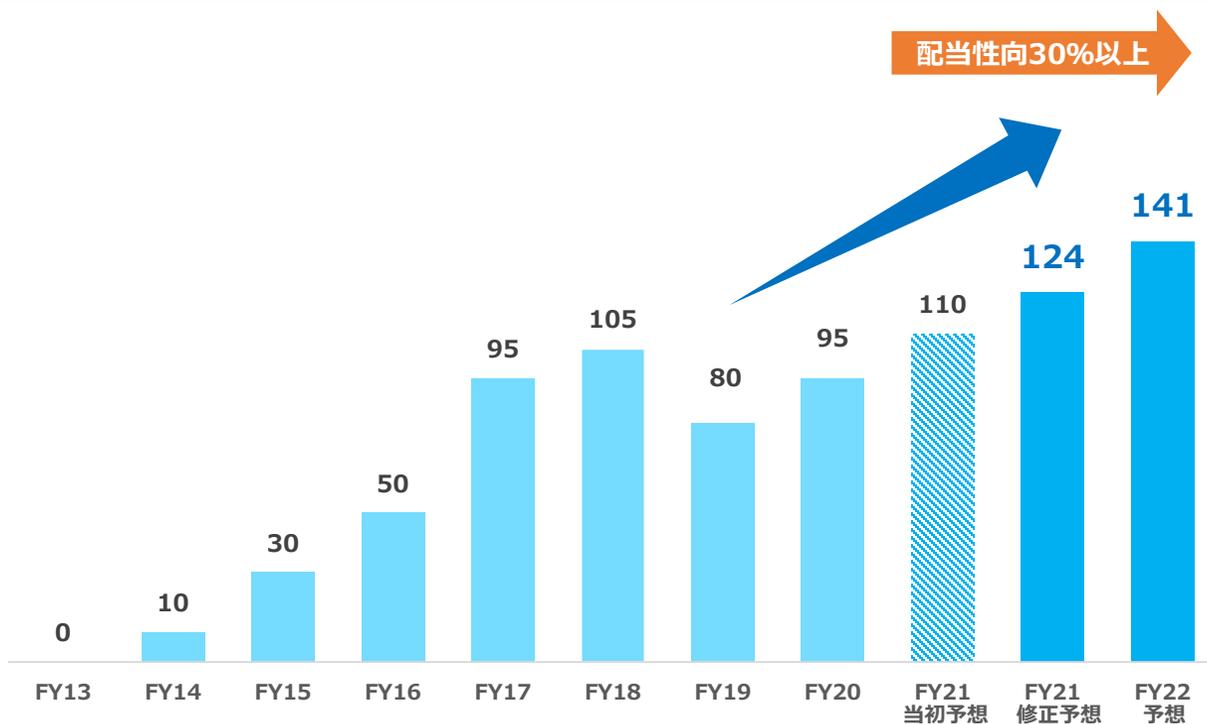
	中期経営計画の取り組み（計画）		成果・進捗評価	
成長事業の強化 研究開発力強化	半導体	ロジックの微細化工程新規参入 メモリ投資再開・新工程参入	ロジック・メモリ投資堅調⇒売上計画超過 MHM工程+他工程参入+顧客拡大で成長	
	電子	モジュール化による提案装置拡大 中国での開発・営業・サポート体制強化	パワー・オプト・電子デバイス等の投資活発化 ⇒日本・中国を中心に売上計画超過 モジュール化「uGmniシリーズ」で提案装置拡大 中国営業・技術サポート体制強化で売上計画超過	
	FPD	大型基板OLED量産開発 利益体質に転換	LCD投資継続・OLED化で売上計画超過 着実にモノづくり力強化実施→利益率改善	
モノづくり力強化	技術設計・調達・生産一体改革 ⇒生産性向上⇒利益率改善		部材長納期化等により最終年度目標利益率未達も 各種施策を着実に実施→利益率は着実に改善	
グループ経営効率強化	ビジネスユニット経営推進 自社製品を持つグループ会社の経営強化		韓国グループ会社統合 国内製造子会社2社の吸収合併 各社にて経営改革を推進	
経営基盤強化	人財育成・活性化		新人事制度導入 教育センター設立	
	情報システム基盤強化		生産性向上に向けた各種システム整備を着実に実施	
	財務基盤強化		ROE 11.4% 営業CF 339億 (自己資本比率：53.3%)	

11. 株主還元

- 株主還元は最重要政策の一つ。更なる成長により、増配による株主還元を目指す
(着実に配当を増額、21年度より配当性向30%以上を目標に)
- 顧客の設備投資動向の変動・技術革新の激しい業界
⇒成長領域への研究開発投資力確保を最重視。業界変動への対応や業績変動リスクへ対応のため財務基盤も拡充

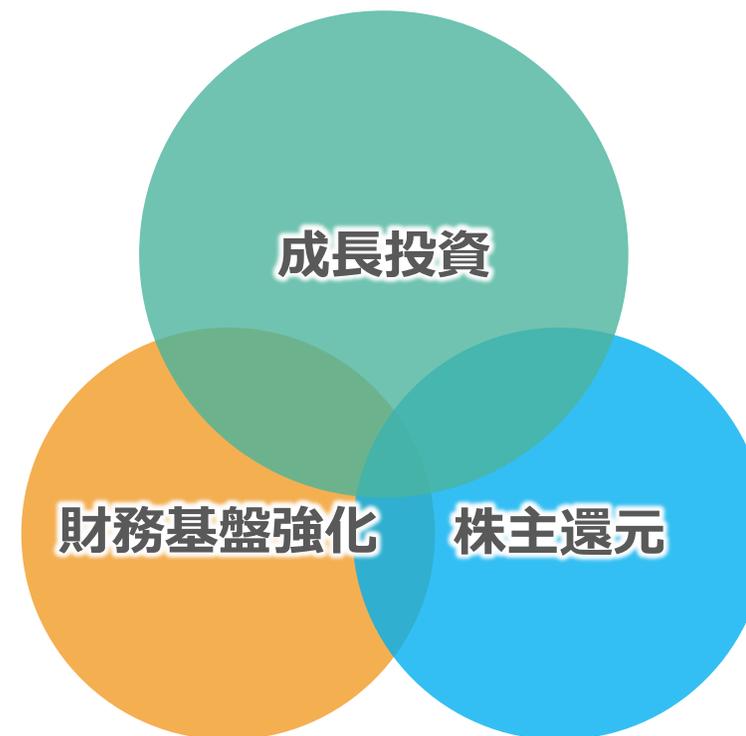
1株当たり配当金・配当性向推移

【単位：円】



【単位：%】

年度	配当性向 (%)
FY13	-
FY14	5.8
FY15	8.9
FY16	10.1
FY17	13.0
FY18	27.7
FY19	36.6
FY20	31.5
FY21 当初予想	30.1
FY21 修正予想	30.2
FY22 予想	30.2



次期中期経営計画を策定し、23年8月に公表予定

以下の成長分野に開発投資を集中し、増収増益・利益率向上を図る方針

半導体・電子

- 先端ロジックMHM工程に加え、配線工程等他工程参入・他社採用で成長
- メモリ投資に頭打ち感が見られる中、セカンドベンダー期待もあり他工程参入で成長
- 日中のパワーデバイス・各種電子デバイスの技術革新投資への対応・モジュール型装置投入で成長
- 中国の国産化対応で成長

FPD

- 大型基板OLEDのスパッタ装置・バッテリー用巻取り蒸着装置で成長



よくある質問



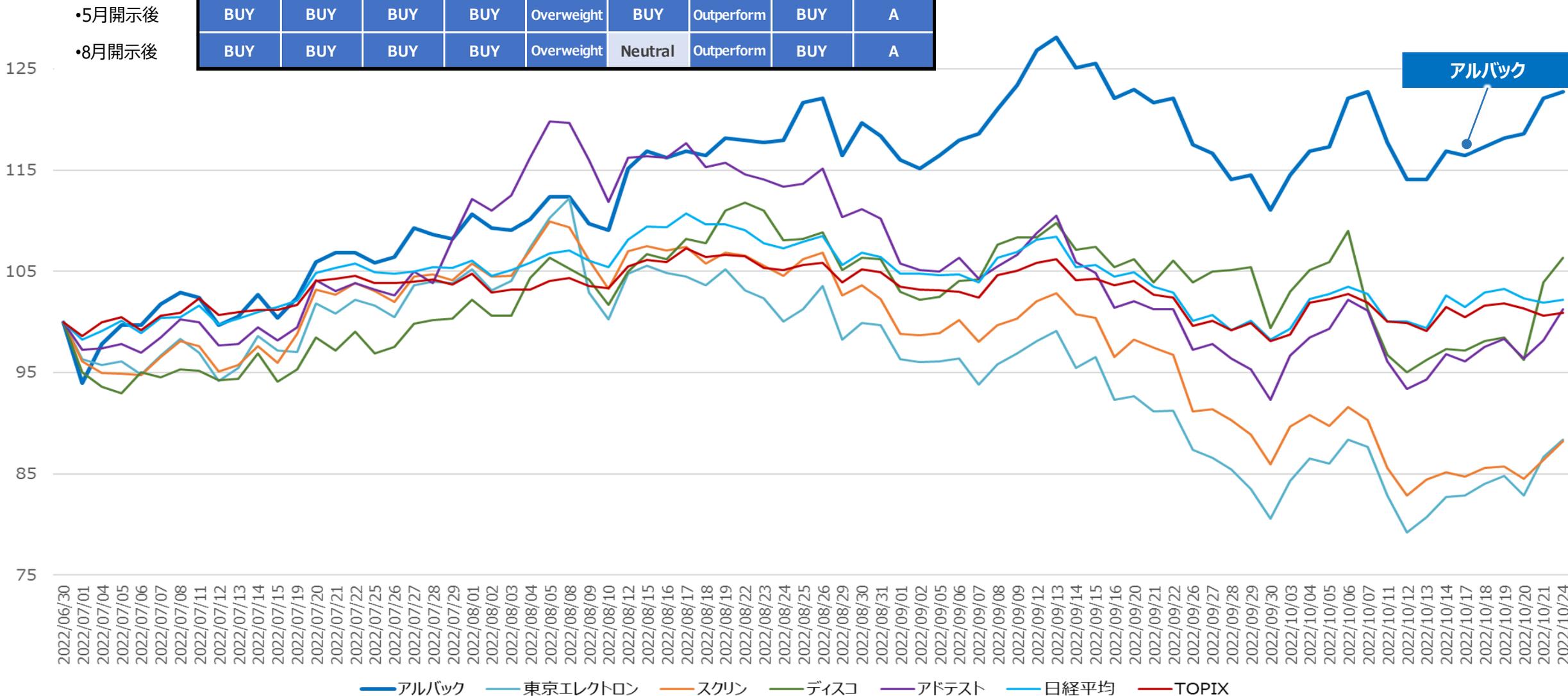
1. 米国の中国半導体輸出規制等の影響



2. 半導体投資動向・成長ドライバー

(ご参考) 株価推移・アナリスト評価

	みずほ	野村	ジェフリーズ	GS	JPモルガン	BofA	マッコーリー	丸三	岩井コスモ
・5月開示後	BUY	BUY	BUY	BUY	Overweight	BUY	Outperform	BUY	A
・8月開示後	BUY	BUY	BUY	BUY	Overweight	Neutral	Outperform	BUY	A



スマート社会・ デジタル社会実現



グリーンエネルギー化 低消費電力化

社会的課題解決

メモリ

ロジック IC

センサー

通信デバイス

バッテリー

微細化

高性能化

低消費電力化

スパッタリング

エッチング

真空蒸着

真空薄膜形成技術

CVD

コンポーネント

マテリアル

カスタマーサポート